



2DK1100L 型硅肖特基整流二极管

1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件有 D2-03B 型玻璃封装。

具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，D2-03B 典型重量 235mg。



D2-03B

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611；

JCT 级：Q/RBJ 21385-2020。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	I_{FM} mA	V_{RM} V	V_{RWM} V	I_{FSM} $t_p=8.3\text{ms}$, $T_A=25^\circ\text{C}$ A	T_j °C	T_{stg} °C
2DK1100L	1500	100	80	15	-55~150	-55~150

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

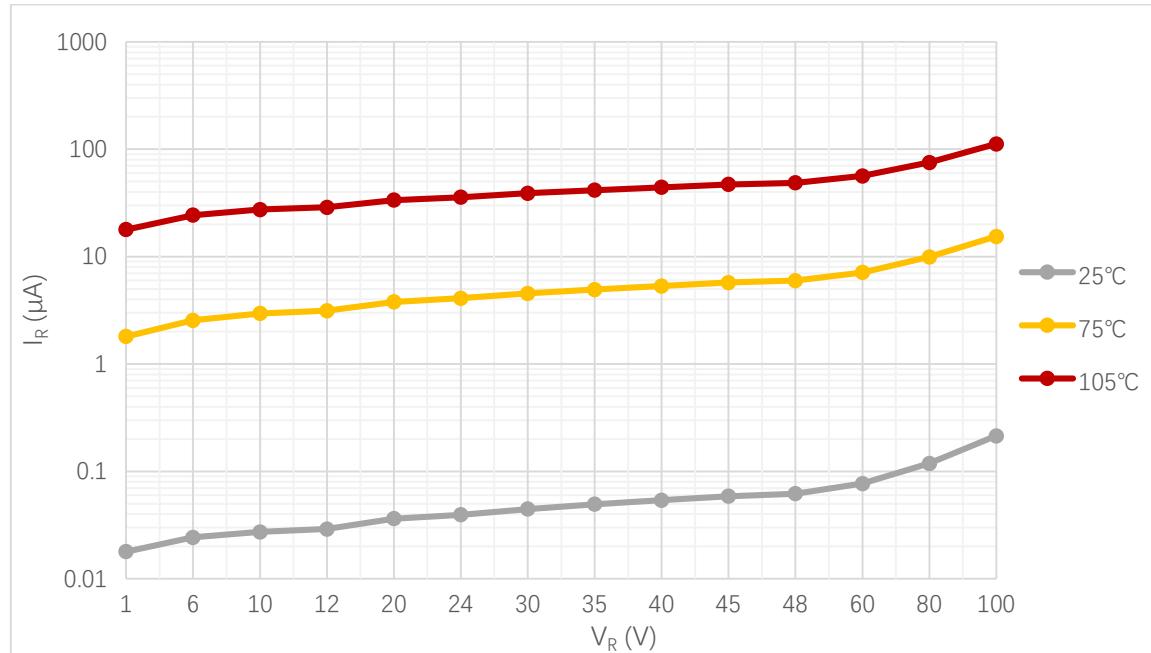
表 2 主要电特性

序号	符号	测试条件	规范值
1	正向压降 V_{FM1}	$I_F=1500\text{mA}$	$\leq 0.75\text{V}$
2	正向压降 V_{FM2}	$T_A=-55^\circ\text{C}$, $I_F=1500\text{mA}$	$\leq 1.5\text{V}$
3	反向电流 I_{R1}	$V_R=64\text{V}$	$\leq 5\text{ }\mu\text{A}$
4	反向电流 I_{R2}	$T_A=105^\circ\text{C}$, $V_R=64\text{V}$	$\leq 6\text{mA}$

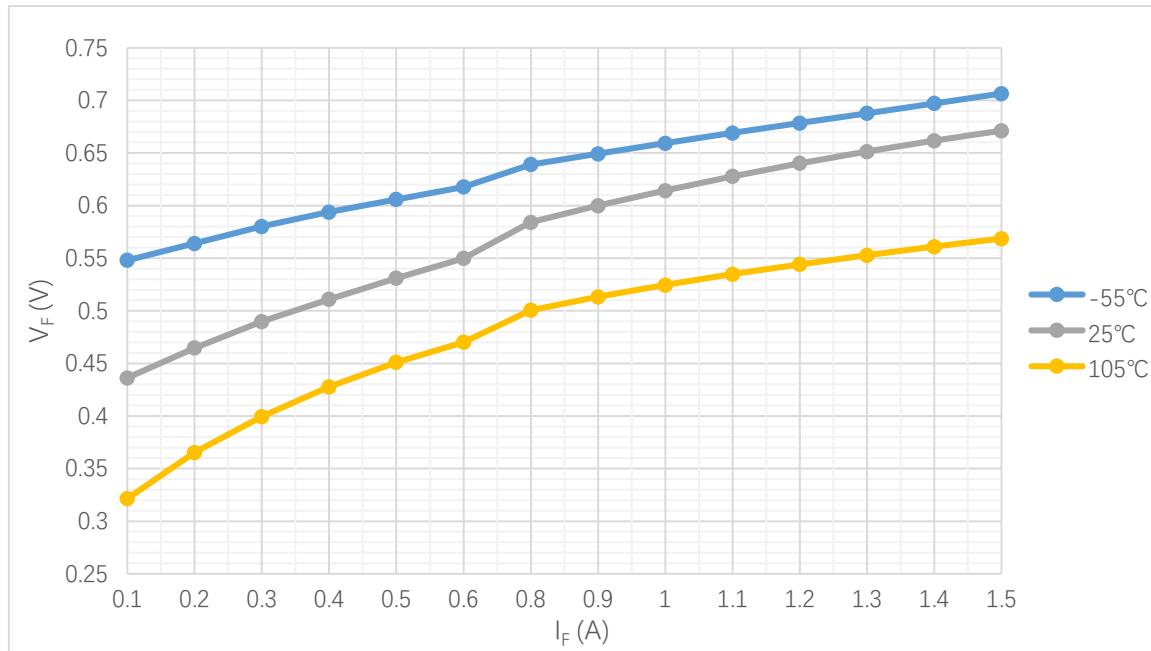


5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电压下的反向电流曲线

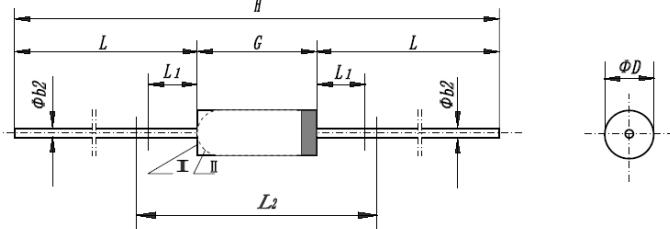
图 1 I_R - V_R 特性曲线

5.2 不同温度、不同电流下的正向电压曲线

图 2 V_F - I_F 特性曲线



6 外观尺寸



注: ① L_1 尺寸指在此段内引线直径不予限制, 以允许引线涂料和表面少量的凹凸不平存在。
② L_2 为引线弯曲成直角后器件安装的最小轴向长度。
③ 主体形状允许采用两种形式, 见图中轮廓线 I 、 II 。

单位为毫米

代号	D2-03B	
符号	最小值	最大值
$\phi b2$	0.458	0.558
ϕD	—	3.20
G	—	7.62
H	60	—
L	26	—
$L1$	—	2.5
$L2$	16	—

图 3 D2-03B 外形尺寸